

H29年度電子・量子工学専攻 卒業論文発表会プログラム

日時: 2018年2月8日(木)8:40~17:47, 場所: 3A308

発表要領: 発表時間1人13分(発表7分、質疑5分、交代1分) 会場責任者: 岩室 憲幸

順番	開始時刻	学籍番号	氏名	題目	指導教員	座長
1	8:40			光触媒BiVO ₄ の成膜研究	櫻井	岡本
2	8:53			陽電子消滅法によるCFRP樹脂の自由体積評価	上殿・Selvakumar	
3	9:06			SiC上酸化膜のエッチングレート	蓮沼	
4	9:19			NiFe ₂ O ₄ /MgAl ₂ O ₄ (001)の界面磁性	柳原, Sharmin	
5	9:32			時間分解THz-STMの開発と光励起ダイナミクス計測	重川・武内	
6	9:45			陽電子消滅法によるCFRPの欠陥評価	上殿・Selvakumar	
7	9:58			As ₂ を用いた分子線エピタキシーによるGaAs(110)量子井戸構造の作製とキャリア・スピン寿命の測定	大野	
8	10:11			直列補償回路を用いた電気自動車用非接触給電の検討	只野・磯部	
9	10:25			SiC-MOSFETを用いたDC/DC変換器設計法の検討	只野・磯部	
	休憩					
10	10:50			SiC酸化初期のSiC-SiO ₂ 界面欠陥の電子スピン共鳴分光	梅田	岡本
11	11:03			多探針STMを用いた遷移金属ダイカルコゲナイド系層状物質の電気伝導特性計測	重川・武内	
12	11:16			CAFMを用いたSiC上極薄熱酸化膜の電気伝導解析	蓮沼	
13	11:29			光照射STMの低分子薄膜太陽電池への応用	重川・武内	
14	11:42			MBE法によるMn _{4-x} Ni _x N薄膜の成長と磁気特性評価	末益・都甲	
15	11:55			外場誘起によるガン細胞構造変化の観察	重川・武内	
16	12:08			光電子放出を用いたSTM探針におけるTHz増強電場波形の計測	重川・武内	
17	12:21			BaSi ₂ 太陽電池の変換効率向上に向けたITO堆積条件の最適化	末益・都甲	
18	12:34			SiC nチャネルおよびpチャネルMOSFETの破壊耐量に関する比較解析	岩室・矢野	
	休憩					
19	13:40			多層グラフェンの金属誘起層交換成長における触媒金属種の検討	末益・都甲	植田
20	13:53			SiC-SiO ₂ 界面の窒化処理によって発生する界面欠陥の電流検出電子スピン共鳴分光	梅田	
21	14:06			Al誘起成長を利用した絶縁体上Ge光吸収層の結晶成長	末益・都甲	
22	14:19			p型SiC MOS構造における酸化膜リーク電流伝導メカニズムの解析	岩室・矢野	
23	14:32			陽電子消滅法を用いたMg注入GaNの空孔型欠陥の評価	上殿・Selvakumar	
24	14:45			GaAs/AlGaAs(110)量子井戸構造におけるスピン緩和時間の温度・励起強度依存性	大野	
25	14:58			電解液中での容量-電圧特性評価用セルの設計	蓮沼	
26	15:11			デバイス構造を考慮した単原子層半導体のモンテカルロシミュレーション	佐野・植田	
27	15:24			Si硝酸酸化膜の界面物性評価	櫻井	
	休憩					
28	15:50			自己無撞着モンテカルロ法による非対称ダブルゲートMOSFETの特性評価	佐野・植田	植田
29	16:03			ヘテロエピタキシャル歪を導入したコバルトフェライト微粒子の磁気特性	柳原, Sharmin	
30	16:16			1.2kV 4H-SiC SJ-IEUMOSFETの低オン抵抗化に向けた構造の研究	岩室・矢野	
31	16:29			m面SiC MOS構造へのSiN界面層適用の研究	只野・磯部	
32	16:42			モンテカルロシミュレーションを用いた単原子層半導体における電気伝導と熱特性の考察	佐野・植田	
33	16:55			MBE成長速度を変化させたBaSi ₂ エピタキシャル膜の特性評価	末益・都甲	
34	17:08			Mnフェライト(001)エピタキシャル薄膜の作製	柳原, Sharmin	
35	17:21			電気伝導性酸化物ReO ₃ 薄膜のエピタキシャル成長	柳原, Sharmin	
36	17:34			CIGS太陽電池における熱光照射効果の解析	櫻井	